

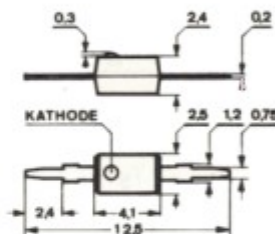
BB 110**Silizium-Epitaxial-Planar-Diode für Frequenzabstimmung im UKW-Bereich.**

Silicon epitaxial planar diode for tuning FM-frequencies.

Abmessungen · Dimensions

Maße in mm

M 2:1



Kunststoffgehäuse
SOD 23
Gewicht · Weight
max. 0,1 g

Absolute Grenzwerte · Absolute maximum ratings

Sperrspannung	U_R	30	V
Durchlaßstrom	I_F	100	mA
Sperrschichttemperatur	t_j	100	°C
Lagerungstemperatur	t_{stg}	-55...+100	°C



BB 110

Min. Typ. Max.

Kenngrößen · CharacteristicsUmgebungstemperatur $t_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$, falls nicht anders angegeben

Sperrstrom

 $U_R = 30\text{ V}$ I_R 1 20 nA $U_R = 30\text{ V}, t_{amb} = 60^{\circ}\text{C}$ I_R 5 200 nA

Diodenkapazität

 $U_R = 3\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $C_D^{1)}$ 27 31 pF $C_D^{2)}$ 29 33 pF $U_R = 30\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ C_D 11 pF

Kapazitätsverhältnis

 $U_R = 3\ldots 30\text{ V}, f = 1\text{ MHz}$ $\frac{C_D (3\text{ V})}{C_D (30\text{ V})}$ 2,65

Temperaturkoeffizient

 $U_R = 3\text{ V}$ TK_{CD} 0,04 %/ $^{\circ}\text{C}$

Serienwiderstand

 $C_D = 30\text{ pF}, f = 100\text{ MHz}$ r_s 0,3 0,4 Ω ¹⁾ gekennzeichnet durch einen grünen Punkt.
marked with a green colour dot.²⁾ gekennzeichnet durch einen blauen Punkt.
marked with a blue colour dot.